

**РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ  
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ**

**“СТОЙКОСТЬ-2007”**

**Научно-технический сборник**

**Выпуск 10**



---

---

**РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ  
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ**

**«СТОЙКОСТЬ-2007»**

**Научно-технический сборник**

**Выпуск 10**

**Москва 2007 г.**



УДК 004(06)+621.38(06)+681.5(06)  
ББК 32.973.202я5+32.85я5+32.965я5  
Н34

**Научно-технический сборник «Радиационная стойкость электронных систем – Стойкость-2007».- М.: МИФИ, 2007. 228 с.**

Настоящий научно-технический сборник содержит тезисы докладов Российской научной конференции «Радиационная стойкость электронных систем – Стойкость-2007» (НИИ Приборов, г.Лыткарино, 5-6 июня 2007 г.).

Тезисы, опубликованные в сборнике, рекомендованы к изданию Оргкомитетом конференции.

Материалы издаются в авторской редакции.

В сборнике опубликованы материалы, представленные в Оргкомитет до 15 апреля 2005 г.

ISBN 978-5-7262-0753-7

© Авторы и представляющие  
организации, 2007

<i>O.B.Мещуров, B.B.Емельянов, K.I.Таперо, M.B.Каменский</i> Результаты исследований радиационной стойкости микросхем DS18B20 при воздействии импульсного и стационарного ионизирующих излучений	215
<i>B.H.Афанасьев, B.B.Братчиков, A.M.Гафаров, N.P.Кураков, B.YU.Кононенко, A.I.Кормилицын, B.N.Лаврентьев, B.G.Леваков, Э.П.Магда, Э.В.Моисеенко, Г.В.Мокичев, B.B.Плохой, A.A.Снопков</i> Экспериментальная база установок РФЯЦ-ВНИИТФ для радиационных исследований и испытаний изделий электронной техники	218
<i>A.M.Пономаренко, C.A.Роднов, B.M.Романенко</i> Экспериментальное моделирование фактора 7.К фактором 7.С при испытании модулей питания в диапазоне температур.	221
<i>D.M.Иващенко, H.G.Мордасов, B.D.Шиян, B.A.Каменский, A.P.Метелёв</i> Система диагностики режима работы импульсной моделирующей установки на основе ускорителя электронов	222
<i>D.M.Иващенко, H.G.Мордасов, A.M.Членов</i> Оперативное дозиметрическое обеспечение при радиационных испытаниях элементной базы РЭА на ускорителях электронов	223
<i>P.B.Лагов, A.C.Дренин, A.B.Паничкин, A.L.Мельников</i> Экспериментальная оценка радиационной стойкости переключательных p-i-n диодов	224
<i>B.K.Петин, C.B.Шляхтун, B.I.Орешкин, H.A.Ратахин</i> Источник гамма-рентгеновского излучения на основе трехкольцевого диода для облучения объектов большой площади	225
<i>A.C.Пузанов, C.B.Оболенский</i> Моделирование радиационно-стимулированного вторичного пробоя мощного СВЧ биполярного транзистора	226
<i>B.B.Братчиков, K.A.Гагаринов, B.M.Зверев, A.I.Кормилицын, B.B.Перешитов, B.B.Плохой, C.H.Рукин, B.G.Шпак, M.I.Яландин</i> Мощный источник электромагнитного излучения в трехсантиметровом диапазоне длин волн	227
<i>H.B.Жарова, B.I.Орешкин, B.C.Седой, H.A. Ратахин, B.F.Федущак, A.A.Эрфорт</i> Компактные импульсные генераторы тока: разработка и примеры применения	228

## ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫХ Р-І-Н ДИОДОВ

П.Б. Лагов, А.С. Дренин, А.В. Паничкин, А.Л. Мельников

МИСиС

Исследовано влияние облучения быстрыми (6 МэВ) электронами на прямую вольт-амперную характеристику переключательных р-і-п диодов с различной шириной і-слоя. Определены значения потоков быстрых электронов, при которых наблюдается рост прямого падения напряжения на 50 %.

Исследовано влияние облучения быстрыми (6 МэВ) электронами на прямую вольт-амперную характеристику кремниевых переключательных р-і-п диодов с различной шириной і-слоя (30, 80, 145 и 210 мкм). Облучение проводили при плотности потока быстрых электронов  $2 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$ . Диоды с шириной і-слоя 210 мкм были изготовлены по диффузионной технологии, остальные – по эпитаксиальной. Данные диоды предназначены для работы в коммутационных устройствах сантиметрового, дециметрового метрового и КВ диапазонов волн. Одним из критериальных параметров, по изменению которого можно оценить радиационную стойкость СВЧ диодов, является прямое падение напряжения в статическом режиме. В связи с этим определены значения потоков электронов  $\Phi_{0,5}$ , при которых прямое падение напряжения возрастает (при плотности тока 10 А/см<sup>2</sup>) на 50 % (см. рис.).

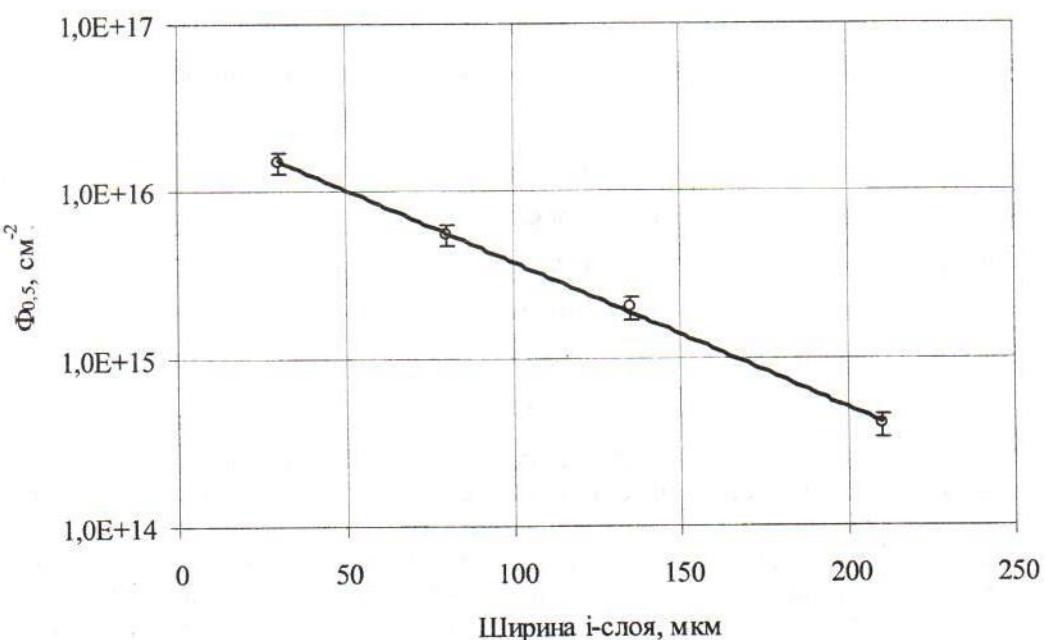


Рисунок – Зависимость  $\Phi_{0,5}$  от ширины і-слоя р-і-п диодов